【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成19年6月21日(2007.6.21)

【公開番号】特開2001-316866(P2001-316866A)
【公開日】平成13年11月16日(2001.11.16)
【出願番号】特願2000-135176(P2000-135176)
【国際特許分類】
Ｃ２５Ｄ　7/12　(2006.01)
Ｃ２５Ｄ　5/34　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/28　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/288　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２５Ｄ　7/12
Ｃ２５Ｄ　5/34
Ｈ０１Ｌ　21/28　A
Ｈ０１Ｌ　21/288　E

【手続補正書】
【提出日】平成19年4月26日(2007.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
メッキ形成を促進させる材料とメッキ形成を抑制させる材料とを含む処理剤を被処理基板面に付着させる工程と、
前記処理剤が付着された前記被処理基板面にメッキを施す工程と
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記付着させる工程は、前記被処理基板を回転させて前記処理剤を前記被処理基板に付着させることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
表面にメッキの種付け層が形成された被処理基板を処理空間に導入する工程と、
前記導入された前記被処理基板を前記処理空間で還元処理する工程とをさらに有し、
前記付着させる工程は、前記処理剤を前記還元処理された被処理基板面に付着させることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記処理剤は、濡れ性を増大させる成分を含有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
前記メッキを施す工程によりメッキされた被処理基板面に洗浄液を供給する工程をさらに有することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
被処理基板を回転可能に保持する基板保持部と、前記基板保持部に保持された前記被処理基板面にメッキ形成を促進させる材料とメッキ形成を抑制させる材料とを含む処理剤を供給する処理剤供給ノズルとを備えた処理剤付着ユニットと、

前記処理剤が付着された前記被処理基板面にメッキを施すメッキ処理ユニットと、
前記処理剤付着ユニットから前記処理剤が付着された被処理基板を搬出して前記メッキ処理ユニットに搬入する搬送機構と
を有することを特徴とする半導体装置の製造装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
また、本発明に係る半導体装置の製造方法は、表面にメッキの種付け層が形成された被処理基板を処理空間に導入する工程と、前記導入された前記被処理基板を前記処理空間で還元処理する工程とをさらに有し、付着させる工程が、還元処理された被処理基板面に当該処理剤を付着させるものであってもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
また、本発明に係る半導体装置の製造装置は、被処理基板を回転可能に保持する基板保持部と、基板保持部に保持された被処理基板面にメッキ形成を促進させる材料とメッキ形成を抑制させる材料とを含む処理剤を供給する処理剤供給ノズルとを備えた処理剤付着ユニットと、処理剤が付着された被処理基板面にメッキを施すメッキ処理ユニットと、処理剤付着ユニットから処理剤が付着された被処理基板を搬出してメッキ処理ユニットに搬入する搬送機構とを有することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除

【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】